

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 11 月 24 日 (2005.11.24)

【公表番号】特表 2001-523395 (P2001-523395A)

【公表日】平成 13 年 11 月 20 日 (2001.11.20)

【出願番号】特願 平 10-547366

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/304

B 2 4 B 37/00

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 1 D

B 2 4 B 37/00 C

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 3 月 17 日 (2005.3.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 手続補正書

平成17年 3月17日

特許庁長官殿

## 1. 事件の表示

平成10年特許願第547366号



## 2. 補正をする者

氏名(名称) ミネソタ・マイニング・アンド・  
マニュファクチャリング・カンパニー



## 3. 代理人

住所 〒540-0001  
大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル  
青山特許事務所  
電話 06-6949-1261 F A X 06-6949-0361

氏名 弁理士 (6214) 青山 葆



## 4. 補正対象書類名 請求の範囲

## 5. 補正対象項目名 請求の範囲

6. 補正の内容  
別紙のとおり。

(別紙)

## 請求の範囲

1. 半導体装置の製造に好適なウェーハの表面を改良する方法であって、

a) 表面がエッチングされてある種のパターンを形成する少なくとも1種の第1の材料と、前記第1の材料の表面に配置された少なくとも1種の第2の材料とを含むウェーハを提供するステップと、

b) 前記ウェーハの前記第2の材料を研磨物品に固定された複数の三次元研磨複合体に接触させるステップであって、前記三次元研磨複合体が結合剤中に分散されて固定された複数の研磨粒子を含むステップと、

c) 前記ウェーハの露出面が平坦になり、露出された第1の材料の少なくとも1箇所の領域と露出された第2の材料の1箇所の領域を有するまで、前記第2の材料を前記複数の研磨複合体に接触させた状態で、前記ウェーハを相対的に移動させるステップとを含む方法。

2. 前記第1の材料が誘電性材料を含み、前記第2の材料が導電性材料を含む請求項1記載の方法。

3. 加工液の存在下において前記ウェーハと前記研磨物品を接触させるステップをさらに含む、請求項1または2記載の方法。